Requested Patent:

JP56142629A

Title:

**VACUUM DEVICE:** 

**Abstracted Patent** 

JP56142629;

**Publication Date:** 

1981-11-07 ;

Inventor(s):

TSUMURA SUEO:

Applicant(s):

NEC CORP ;

**Application Number:** 

JP19800046690 19800409;

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L21/205; H01L21/265; H01L21/285; H01L21/302; H01L21/31;

Equivalents:

ABSTRACT:

PURPOSE: To enable continuous treatment in high vacuum by forming a slit, through which semiconductor wafers can pass, to a block connecting several vacuum chambers, the degree of vacuum thereof is increased by stages.

CONSTITUTION:A slit 3A in an extent that semiconductor wafers 1 can pass is made up to a block 3 conneting several vacuum chambers, which have exhaust pipes and the degree of vacuum thereof is increased by stages, and the semiconductor wafers 1 are successively transported to the next vacuum chambers by means of O ring belts 2 (4 are O ring belt holes). Thus, the wafers 1 can continuously be sent into high vacuum chambers from atmospheric pressure without using vacuum valves.

## (9) 日本国特許庁 (JP)

## 印特許出願公開

# ⑩公開特許公報(A)

昭56—142629

	識別記号	庁内整理番号	❷公開 昭和56年(1981)11月7日
H 01 L 21/205		7739—5 F	
21/265		6851—5 F	発明の数 1
21/285	•	76385 F	審查請求未請求
21/302		6741—5F	
21/31		7739—5 F	(全 3 頁)
			·

## 6)真空装置

创特

顧 昭55—46690

②出 顧 昭55(1980)4月9日

の発 明 者 津村末朗

東京都港区芝五丁目33番1号日

本電気株式会社内

⑪出 願 人 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号

砂代 理 人 弁理士 菅野中

#### 明 網 15

## 1.発明の名称

真空装置

#### 2. 特許請求の範囲

(1) 段階的に真空度を高めた幾つかの真空室と、その各真空室を脱気する排気管と、各真空室を混気するが気管と、各真空室を連結するブロックとからなり、ブロックに半導体ウエハースが過過出来る程度のスリットを設け、半導体ウエハースをスリットを設け、半導体の真空室へ移送するのリングペルトをプロックと真空室とに該つて配数してなる真空装置。

## 3.発明の静緩な説明

半導体ウェハースの生産プロセスにおいて、近年、真空中で処理を行う工程が多くなつている。たとえば、蒸着、スペッタリング、ブラズマエッチ、プラズマロVDイオン庄入等である。ところが、大気中のウェハースを処理室である真空室内に入れるに当つて、ほとんどのもの

はパッチ処理によつて行なわれ、又、キャリアックャャリアでないためにウエハースハンドリングが非常に頻雑であつた。

本発明は、複雑な機構を用いずにキャリアからウエハースを一枚ずつ高真空室に送り込み再び大気中のキャリアに連続的に戻すことの出来 る真空装置を提供するものである。

以下本発明の実施例を関によつて説明する。 第1図において、1はウエハース、2はウエハースを乗せて搬送するための0リングペルトである。故ペルト2は、直方体プロック3にあけられた孔4を通して該プロック3及び真空室7にまたがつて配数され、プロック3にはウェハース1が通るととができる福度の大きさのスリット34が開口されている。

第2回はローダ例又はアンローダ側のキャリア 6 からウェハーが出て行き又逆にキャリア 6 に入つてくる部分を示す。凶中7は真空室の一つを示し、8 はその排気音である。5 はキャリアに1 ピッチブつ上下送りを与えるエレベータ

である。

第3回は本発明の金体のシステムの一実施作 を示すものである。キャリア6から出たウェハ ースは 71 ~ 76 ~ 71 までの各英空窟を通り中 ヤリア6に入る。

各裏空室はそれぞれ排気管8尺段けたパルブ 9を介して下記の真空度に排気されている。

室 7: は 10-iforr

室 74 は 10 - Torr

室 74 杖 10-5Torr. (ウエハー処理室)

各寅はそれぞれの真空度に応じた複額のポン プで脱気されている。

木発明において、各真空盆の間にはいつさい パルブがなく真空室の両端には、第1回に示す スリットを持つたプロック3で連結されている。 したがつて、各室の真空度は所要の値に保持 されているかどうかが問題となる。

ブロック3のコンダクタンスCを計算すると 次のとかりである。

ととで、相撲する実空室の真空度を Pa「Torr」 Pn+i「Torr」とするとn 番目の室からn+i番目 の室に使入する(今 Pn>Pn+1 とする) ガス並は

Qin = Pn·C である。

PB+1 室に付いているポンプの実効排気スピー ドモ ユナ180とナれば

n+1<sup>8</sup>e · Pm+1 = Q1n = Pn · Oでペランスする。

 $n+18_6 = \frac{P_n}{P_{n+1}} \cdot c = 100 \cdot c$ (4) (1)、(2)、(3)式の結果からじは殺大でも0.6 「4/8」でもるから

 $_{n+1}^{8} = 100 \times 0.6 = 60 [L/8]$ となり、各国には 60「4/8」 以上の排気スピー ドのポンプをつないでおけば、第3週のシステ ムにより充分に各国の真空度が保たれることが 刊る。

すなわち、本発明の実施例では第1図に示す ブロツク3のスリントの高さュニョ「 nag j スリットの巾 Þ = 100「麻麻」 プロックの扱さ

矩形質のコンダクタンスC「L/B」は 粘性流 ( 760Torr ~ 10-3Torr) に対して  $V_A^C_{R26^CAIR} = 0.26 E_B \frac{a^2 b^2}{L} \frac{pai + pa2}{2}$ 分子茂 ( 10-4 ~ 10-frorr) に対して  $a^2 b^2$  $C_{\text{M R 20 CAIR}} = 30.9 \text{Kr} \frac{a}{(a+b)L} Cb \delta_o$ w ±, a = 0.1[cm] b=10[cm] ℓ=10[cm] P#1 = 760 Torr | .≅ 1000 Torr ] p # 2 = 10 [ Torr ] と する と a/b=(.1/0.01

の時

粘性液で KB ≒ 0.02

分子流で 123 ≒ 2 であるから  $V_{\mu}^{C} = 0.26 \cdot 0.02 \cdot \frac{0.1^{2} \times 10^{2}}{10} - \frac{1000 + 10}{2}$ = 0.26[4/8] (760Torr(AIM)~10Torr) 同様に

⇒ 0.0026 4/8 ] (10Torr ~ 10 Torr).(1)  $_{\rm M}^{\rm C}_{\rm R}$ =30.9 × 2 ×  $\frac{0.1^2 \times 10^2}{(0.1+10)\times 10}$ = 0.6[4/8] (10-4~ 10-4Torr)

(3)

ℓ=100「ໝ」とし、各真空室にはそれぞれの.矣 空度に応じた種類の実効排気スピード60「L/8」 以上の排気系及びポンプを設ける事により図る 化示す根をシステムで両端網放 でウェハースを 大気圧から 10<sup>-5</sup>「Torr」に放圧し、又遊に大気圧 まで連続的に通過させることが可能となつた。

以上のように本発明によれば、何ら真空ペル ブを用いる事なくウエハースを大気圧から高真 空室内に連続的に送り込み、又逆に高真空室内 より連続的に大気中にウエハースを取出す事が でき、全行程をロリングペルトに乗せてキャリ アンウキャリアで処理を行なりことができる。 なね、弟3因のシステムは一実施例であり、

処理室の真空度 10<sup>-5</sup>「Torr」にとどまらす、 さらに、高真空(実際はポンプその他の関係で 10<sup>-7</sup>「Torr」根変)に上げることも可能である。 4.図面の簡単な説明

 $P_{D+1} = 10^{-2} \cdot P_{D} \ \text{etal}$ 

第1図は各真空窟連結プロックの斜視図、第 2図はロード、アンロード婚毎を示す歯面図、

#### 競3図は全システム系統図である。

- 1 …ウエハース
- 2 … 0 リングペルト
- 3 ... プロック
- 3A … スリット
- 4 …0リングペルト穴
- 5 …キャリアエレペータ
- 6 -- 4 7 9 7
- 7 … 71 ~ 74 英空盒
- 8 … 排気管
- 9 ーペルブ

#### 特許出願人 日本電気株式会社

#### 代理人 弁理士 蕾 野 中

